

III. Bài tập áp dụng:

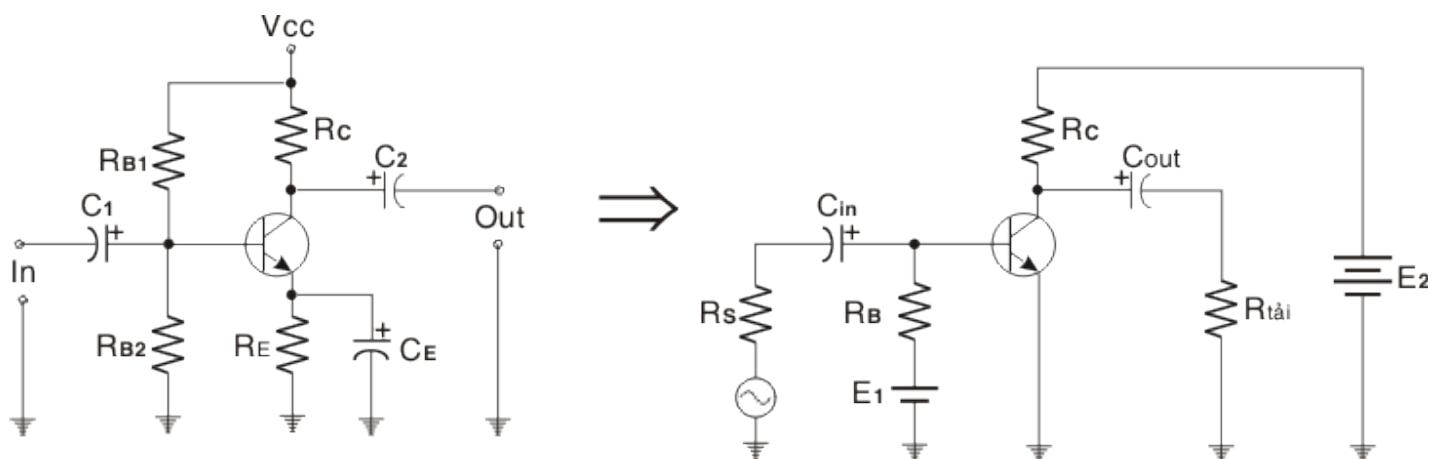
1. Tính phân cực ban đầu của transistor:

a. Phương pháp toán học:

▪ Điện áp phân cực ban đầu:

Với mạch điện sau: cho $R_{B1} = 68K$; $R_{B2} = 12K$; $R_E = 0,5K$; $R_C = 2,5K$; $V_{CC} = 12V$; $\beta = 100$, tính điện áp phân cực ban đầu.

Theo biến đổi Thevenin ta có mạch tương đương như hình 3.32



Hình 3.32

$$E_1 = V_{BB} \cdot \frac{R_{b2} \cdot V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} = \frac{12000}{80000} \cdot 12 = 1,8V$$

$$R_B = \frac{R_{b1}R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = \frac{68000}{68000} \cdot \frac{12000}{12000} = 10000 \cdot 10^k$$

$$I_b = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + R_E} = \frac{1,8 - 0,6}{10000 + 500} = \frac{1,2}{10000 + 50000} = 2 \cdot 10^{-5} A = 0,02mA$$

$$I_C = I_b = 100 \times 2 \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 10^{-3} A = 2mA = I_E$$

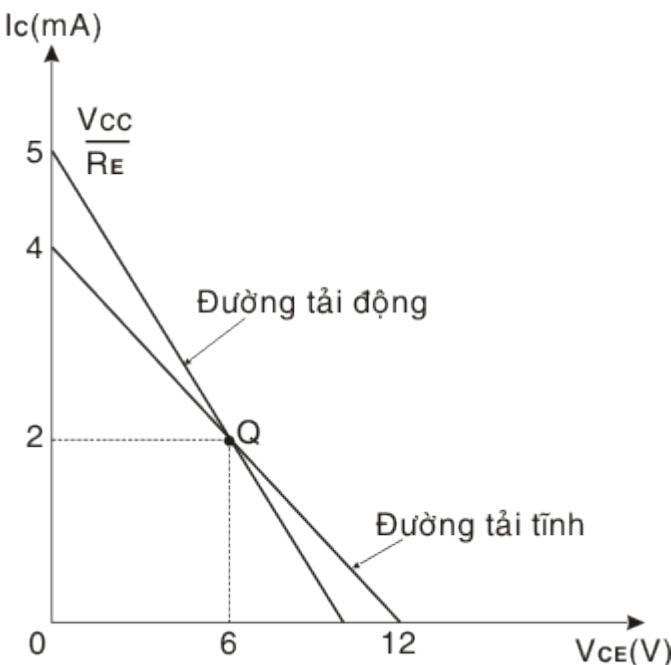
$$V_E = I_E \cdot R_E = 2 \cdot 10^{-3} \times 500 = 1V$$

$$V_B = V_E + 0,6 = 1 + 0,6 = 1,6V$$

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 12 - 2 \cdot 10^{-3} \times 2500 = 7V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 7 - 1 = 6V$$

▪ Đường tải tĩnh – Đường tải động:



Hình 3.33

$$I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{2500 + 500} = 4.10^{-3} A = 4mA$$

$$I_{C(AC)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12}{2500} = 4.8 \cdot 10^{-3} A = 4.8mA$$

▪ **Tổng trớn ngo vào:**

$$R_L = h_{ie} = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}} 100 = 1300 \Omega = 1.3K$$

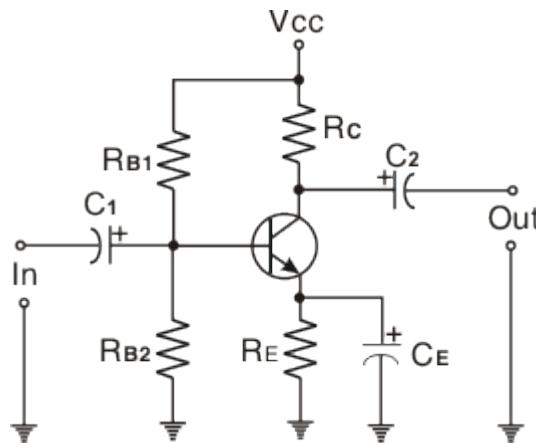
a. **Phương pháp đồ thị:**

Ta có: $I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$

Đường tải tĩnh đi qua 2 điểm: $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$ và $V_{CE} = V_{CC}$

2. Thiết kế mạch khuếch đại tuyến tính:

a. **Chọn kiểu mạch khuếch đại:**



Hình 3.34

$$V_{CC} = 9V$$

$$= 100$$

$$r_i = h_{ie} = 2.5k$$

$$\bar{S} = 20$$

Tính I_E , I_C , R_E , R_C , R_B

b. Xác định điểm làm việc tĩnh của Transistor:

$$\text{Ta có } h_{ie} = r_b + \beta r_e \quad r_e = \frac{h_{ie}}{100} = \frac{2.5}{100} = 25$$

Mặt khác điện trở r_e còn được tính theo công thức

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} \quad I_E = \frac{26mV}{r_e} = \frac{26mV}{25} = 1mA \rightarrow I_C = I_E = 1mA.$$

Chọn R_E và R_C sao cho $V_{CE} = 1/2V_{CC}$ và $I_E \cdot R_E = 1/10V_{CC}$

c. Tính giá trị điện trở:

- Tính R_E

$$\text{Chọn } I_E \cdot R_E = 1/10V_{CC} \quad R_E = \frac{V_{CC}}{10I_E} = 0.9k$$

Chọn R_E theo giá trị tiêu chuẩn là 1k

- Tính R_C

Chọn R_C sao cho $V_{CE} = 1/2V_{CC} = 0.45V$

Ta có $V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - I_E R_E}{I_C} = \frac{9 - 4.5 - 1.1}{1} = 3.5k$$

Chọn $R_C = 3.9k$

Khi chọn R_C và R_E theo chuẩn thì điện áp V_{CE} bị thay đổi chút ít trên đặt tuyến I_C và V_{CE}

- Tính R_{b1} và R_{b2}

Để tính R_{b1} và R_{b2} thì đầu tiên phải tính trị số R_B và V_{BB} theo mạch điện được quy đổi theo định luật Thevenin.

Ta có công thức hệ số ổn định nhiệt: $\bar{S} = \frac{R_B}{R_E} = 20 \quad R_B = 20R_E$

$$R_B = 20.1 = 20k$$

Theo mạch điện ở ngõ vào ta có: $V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$

$$\text{Trong đó } I_E = 1\text{mA}, I_B + \frac{I_C}{100} \text{ mA}$$

Thay vào ta có $V_{BB} = 0.01 \times 20 + 0.6 + 1.1 = 1.8V$

$$\text{Mặt khác } V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \text{ và } R_B = \frac{R_{b1} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

Giải hệ 2 phương trình 2 ẩn số này ta được trị số R_{b1} và R_{b2} là:

$$R_{b1} = 100k, R_{b2} = 27k$$

d. Nghiệm lại: trình tự nghiệm lại trên mạch điện giống như cách tính trạng thái 1 chiều theo phương pháp toán học và tính trên mạch điện đã thiết kế:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 9 \frac{27}{100 + 27} = 1.9V$$

$$R_B = \frac{R_{b1} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = \frac{100 \times 27}{100 + 27} = 21.25k$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{1.9 - 0.6}{21.25} = 0.01mA \quad I_C = I_E = I_B = 100 \times 0.01 = 1mA$$

- Điện thế các chân transistor là:

$$V_E = I_E \cdot R_E = 1 \times 1 = 1V$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 1.6V$$

$$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 9 - 1 \times 3.3 = 5.7V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5.7 - 1 = 4.7V$$

Mạch điện đã có các giá trị điện trở với trị số theo tiêu chuẩn.

e. Nghiệm lại theo phương pháp đồ thị:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_E} \quad \text{Nếu } V_{CE} = 0 \text{ thì} \quad I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = 2.1mA$$

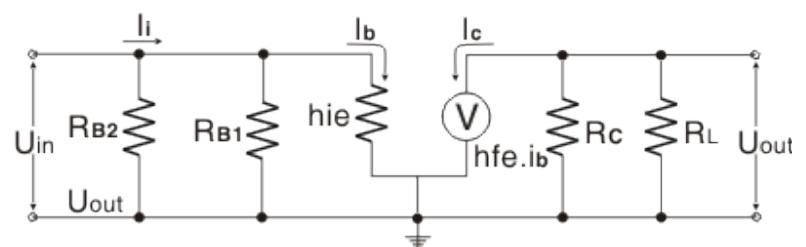
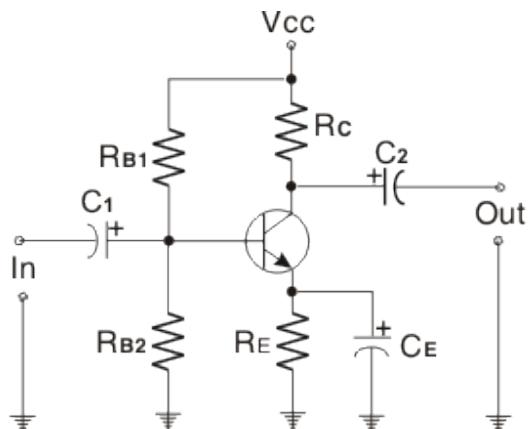
Nếu $I_C = 0$ thì $V_{CE} = V_{CC}$

Đường tải tĩnh là đường thẳng nối 2 điểm. $V_{CE} = 9V$ và $I_C = 2.1mA$

Điểm làm việc Q có tọa độ là $V_{CE} = 4.7V$ và $I_C = 1mA$.

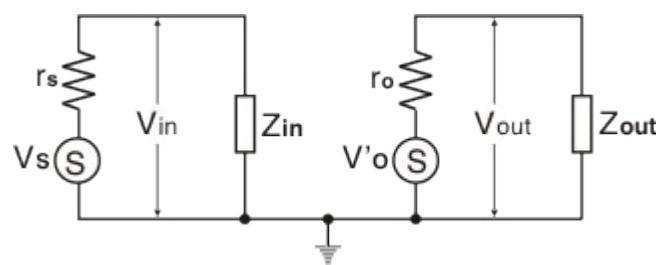
2. Tính các thông số ở trạng thái xoay chiều:

a. Phân tích mạch khuếch đại bằng mạch tương đương:



Hình 3.35: Mạch khuếch đại điện hình

Hình 3.36: Mạch tương đương theo thông số h



Hình 3.37: Mạch tương đương rút gọn

- hie: Tổng trở vào của transistor mắc kiểu E chung.
- Z_i : Tổng trở vào của mạch khuếch đại.

$$Z_i = R_{b1} // VR_{b2} // hie$$
- R_o : Tổng trở ngõ ra của transistor.
- V'_o : Điện áp ngõ ra lúc không tải.
- V_o : Điện áp ngõ ra lúc mạch có tải.
- $Z_L = R_C // R_L$

Từ 2 mạch tương đương ta tính được các thông số sau:

- Tổng trở ngõ vào: $Z_i = R_{b1} // R_{b2} // hie$ với $R_B = \frac{R_{b1}R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$ $Zi = \frac{R_B.hie}{R_B + hie}$
- Điện áp tín hiệu vào: $V_i = Vs \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_s}$
- Độ khuếch đại điện áp của Transistor:
 - Tải của mạch là: $Z_L = R_C // R_L \rightarrow Z_L = \frac{R_C.R_L}{R_C + R_L}$
 - Hệ số khuếch đại của Transistor là: $AV = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_L}{Z_i}$
 - Hệ số khuếch đại toàn mạch là: $AV_s = AV \cdot \frac{V_i}{V_s} = \frac{Z_L}{Z_i} \cdot \frac{Z_i}{Z_i + r_s} \rightarrow AV_s = \frac{Z_L}{Z_i + r_s}$
 - Tổng trở ngõ ra: Trong mạch tương đương như hình 3.xxx1 ta còn các quan hệ sau :
 - Điện áp ra khi có tải là: $V_o = V'_o \cdot \frac{R_L}{r_o + R_L}$ (V'_o điện áp ra không tải)

$$\rightarrow V_o(r_o + R_L) = V'_o \cdot R_L \quad , \quad r_o = \frac{V'_o}{V_o} \cdot R_L \quad R_L \Rightarrow r_o = \frac{V'_o}{V_o} - 1 \cdot R_L$$

b. Đường tải động: Đối với tín hiệu xoay chiều các tụ điện liên lạc, tụ thoát (C_E) được xem như nối tắt, nên cực E xem như nối mass. Phương trình đường tải động được viết lại là:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$

Đường tải động là đường thẳng cắt trực I_C tại $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ và đi qua điểm làm việc tĩnh Q.

c. Tính các thông số trường hợp có tụ C_E :

Các thông số được tính theo công thức ở phần 1

$$\text{Tổng trớ vào của transistor là: } h_{ie} = \frac{26mv}{I_E} = \frac{26}{1} \times 100 = 2600 = 2.5k$$

$$\text{Tổng trớ của mạch khuếch đại: } Z_i = \frac{R_B \cdot h_{ie}}{R_B + h_{ie}} = \frac{21 \times 25}{21 + 25} = 2.2k$$

Độ khuếch đại điện áp $A_i = 100$ (cho trước)

$$\text{Độ khuếch đại riêng của transistor: } A_V = \frac{Z_L}{h_{ie}}$$

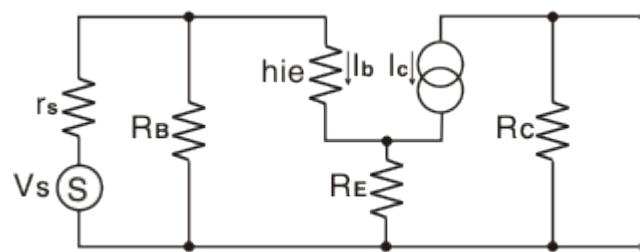
$$\text{Mà } Z_L = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = \frac{3.3 \times 5}{3.3 + 5} = 2k \Rightarrow A_V = \frac{100 \times 2}{2.2} = -90 \text{ Lần}$$

Nếu nguồn tín hiệu vào là mass có nội trớ nguồn là $r_s = 600$ thì độ khuếch đại chung của mạch

$$\text{là: } A_{VS} = \frac{Z_L}{Z_L + r_s} = 77 \text{ Lần}$$

d. Tính thông số trường hợp không có tụ C_E :

Nếu không có tụ C_E thì cực E không được nối mass. Ở trạng thái xoay chiều mạch được vẽ lại như sau:



Hình 3.38: Tính thông số khi không có tụ

Trường hợp này đường tải động cũng chính là đường tia tĩnh, các thông số được tính như sau:

- Tổng trở vào của transistor là:

$$r_i = \frac{v_i}{i_i} - \frac{i_b hie + i_b R_E}{i_b} = hie + R_E$$

$$r_i = 2.5 + 100 \times 1 = 102.5k$$

- Độ khuếch đại điện áp riêng của transistor là:

$$Av = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_C \cdot R_C}{i_B \cdot r_i} = \frac{i_b \cdot R_C}{hie + R_E} = \frac{R_C}{hie + R_E}$$

$$\text{Do } .R_E \gg hie \quad \text{Nên } Av = -\frac{R_C}{R_E} \quad \text{Và} \quad r_i = .R_E$$

$$\text{Như vậy: } Av = -\frac{3.3}{1} = -3.3 \text{ lần}$$

Độ khuếch đại điện áp khi không có tụ C_E bị giảm rất nhỏ, nhưng tổng trở vào rất lớn.